

2SD555/2SB600

NPN/PNP 三重拡散メサ形シリコントランジスタ

NPN/PNP SILICON TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

低周波電力増幅用 / Audio Frequency Power Amplifier

特徴 / FEATURES

- ・実効出力200~300W Hi-Fi アンプの出力用コンプリメンタリパワートランジスタである。

Suitable for output stage of 200 to 300 watts audio amplifier.

- ・パッケージの熱容量が大きく、破壊耐量大きい。

Wide safe operating area and large thermal capacity.

- ・高耐圧、大電流である。

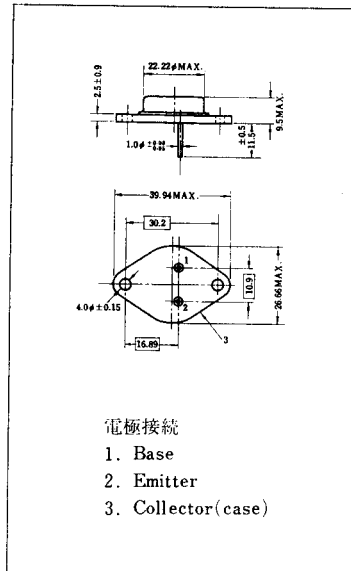
High breakdown voltage, high current. $V_{CE0}=200V$, $I_{C(Pulse)}=15A$

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

項目	略号	2SB600	2SD555	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-200	400	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-200	200	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	5.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$	-10	10	A
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(Pulse)}^*$	-15	15	A
全損失	$P_T(T_a=25^\circ C)$	200		W
ジャンクション温度	T_j	150		$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~+150		$^\circ C$

* $PW \leq 10ms$, duty cycle $\leq 50\%$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

2SB600/2SD555

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -200/200V$, $I_E = 0$			-100/100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3.0/3.0V$, $I_C = 0$			-100/100	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -5.0/5.0V$, $I_C = -50/50mA^*$	20/20	70/50		
	h_{FE2}	$V_{CE} = -5.0/5.0V$, $I_C = -2.0/2.0mA^*$	40/40	70/70	200/200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10/10A$, $I_B = -1.0/1.0A^*$		-1.0/1.0	-3.0/3.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -10/10A$, $I_B = -1.0/1.0A^*$		-1.5/1.5	-3.0/3.0	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10/10V$, $I_C = -1.0/1.0A$		4/7		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10/10V$, $I_E = 0$, $f = 1.0MHz$		400/300		pF

* パルス測定 $PW \leq 350\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

h_{FE} 区分 / h_{FE} Classification

h_{FE2}/S : 40~80 R : 60~120 Q : 100~200